

# 先發電光股份有限公司

best Epitaxy Manufacturing Company Ltd

### 会社概要

ベストエピタキシーマニュファクチャリングカンパニーは、2017年11月に 設立されました。竹南サイエンスパークに2233平方メートルの工場を構え ています。最先端のMOCVDシステムに加え、光エピキタシー分野に精通し た経験豊富な人材を持つ弊社は、お客様に光ファイバー通信と3Dセンシン グの両分野で最も優れた費用効率の光デバイスを提供します。

#### 私たちの経営理念

- アジアで最高の化合物半導体製造 会社になること。
- 最先端のレーザー構造を備えた高 品質ウェハーの提供。

#### 私達の製品

- AS/WB LED (570-980nm)
- · High speed 14G/25G 850nm VCSEL
- 3W 940nm VCSEL
- 10G 850nm GaAs based PIN
- · Customized epitaxial wafers
- · 1250-1600 mm EEL



#### 厳格な品質管理



ISO 9001:2015



# **bEMC**

化合物半導体のエピタキシー専門企業 あなたの最良の選択







# ファシリティ

## bEMC 製品

基板: GsAs; InP

対応ウェハーサイズ: 2 "/ 3" / 4" / 6" 製品タイプ: VCSEL, PD, EEL, LED



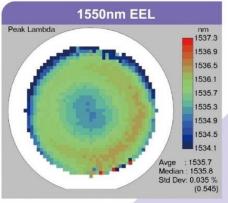


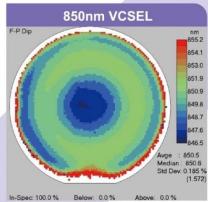


#### 品質管理センター

- X-ray Surface scan machine
- PL system ECV OM







Product	Type	WL(nm)	Wafer size	Substrate	Application	Note
VCSEL	High Power	810	4", 6"	GaAs	Iris recognition	Customization
VCSEL	High Power	850	4", 6"	GaAs	3D sensing; Security	
VCSEL	High Power	940	4", 6"	GaAs	P-Sensor	
VCSEL	High Power	905	4", 6"	GaAs	LiDAR (MJ); Blood oxygen detection	
EEL_FP	High Power	6xx	3", 4"	GaAs	Red light laser	Customization
EEL_FP	High Power	1300	2", 3"	InP	SWIR	Customization
EEL_FP	High Power	1380	2", 3"	InP	3D sensing	
EEL_FP	High Power	1550	2", 3"	InP	LiDAR (MJ, ToF)	
PD		1300	2*, 3*	InP	Under display proximity; Monitor PD; TWS	
11000	110000	050	44.00			
VCSEL	14G/25G	850	4", 6"	GaAs	HDMI, DataCom	
PD	14G/25G	850	4", 6"	GaAs	HDMI, DataCom	
VCSEL	25G	980	4", 6"	GaAs	Automotive Datacom	RD Phase
PD	25G	980	4", 6"	GaAs	Automotive Datacom	RD Phase
EEL_FP	10G	1310	2", 3"	InP	PON, Datacom	
EEL DFB	10G/25G	1270	2*, 3*	InP	PON. Wireless, Datacom	Technology Available
EEL DFB	10G/25G	1290	2", 3"	InP	PON, Wireless, Datacom	Technology Available
EEL_DFB	10G/25G	1310	2", 3"	InP	PON, Wireless, Datacom	Technology Available
EEL_DFB	10G/25G	1330	2*, 3*	InP	PON, Wireless, Datacom	Technology Available

また。顧客の要望に合わせたカスタマイズ化エピタキシーウェハーのファウンダリサービスも提供しています





best Epitaxy Manufacturing Company Ltd



Product	FP Epi Wafer			
Substrate	GaAs	InP	InP	
Size (inch)	3/4	2/3	2/3	
Туре	High Power	High Power	10G	
Wavelength (nm)	635~660	1300/1380/ 1550	1310	
Application	Red light laser	1.SWIR 2.3D sensing 3.LiDAR	1. PON 2. Datacom	

Product	DFB Epi Wafer			
Substrate	InP	InP		
Size (inch)	2/3	2/3		
Type	High Power	10G / 25G		
Wavelength (nm)	1310	1270/1290/1310/1330		
Application	Silicon Photonics	1.PON 2.Wireless 3.Datacom		

Product
Substrate
Size (inch)
Type
Wavelength (nm)
Application

	VCSEL Epi Wafer	
GaAs	GaAs	GaAs
4/6	4/6	4/6
56G PAM4 /100G PAM4	10G / 25G	High Power
850	850/910/940/980	795/810/850/905 /940/980/1064
Datacom	1.HDMI ; AOC 2.Automotive 3.Datacom	1.3D sensing 2.Security 3.LiDAR 4.Gas detector